BA6587K/BA6588K

BA6587K BA6588

FDD 用リード/ライト

Read / Wright Amplifier for FDD

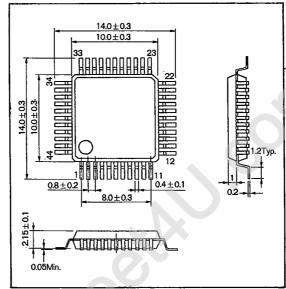
7-52-38

BA6587K, BA6588Kは, 3 インチ, 3.5インチ, 5 インチ 対応フロッピーディスクドライブ用 ICで、ワンチップに リード回路、ライト回路を内蔵しています。

パワーセーブ機能及び5V単一動作により低消費電力を実 現できます。

BA6587K and BA6588K are 3, 3.5 and 5 inch adaptive floopy disk drive IC with read and write circuits incorporated in one chip. Low power consumption is reaized by power saving function and operation with a 5V SUM 1 battery.

◆ 外形寸法図 / Dimensions (Unit:mm)



● 特長

- 1)5V 単一電源動作
- 2) 動作電圧範囲は 4.4~6.0V と広い
- 3) パワーセーブ端子によるスタンバイモードの設定が 可能 スタンバイ時消費電力 6.8mW (5V 時)
- 4) 低消費電力
 - リード時 200mW (5V 時)
 - ライト時 85mW (5V 時, IWR=IER=0mA)
- 5) プリアンプは、47.5dB の差動電圧利得が得られる。
- 6) リードデータ時定数設定用コンデンサ及びパルス幅 設定用コンデンサ内蔵
- 7) 微分定数切り換え回路内蔵
- 8) ライト電流は4段階に切り換え可能(標準密度内周, 標準密度外周,高密度內周,高密度外周)
- 9) タイムドメインフィルタは2段切り換え
- 10) 電源電圧低下検出回路を内蔵しており、電源立ち上 がり時や電源電圧低下時において不正書き込みを完全 に禁止する。

Features

- 1) Opeable with a 5V SUM 1 battery.
- 2) Range of operation voltage is as wide as 4.4 ~ 6.0V.
- 3) Setting of standby mode is possible using the power saving pin. Power consumed in standby 6.8mW (at 5V)
- 4) Low power consumption Upon reading 200mW (at 5V) Upon writing 85 mW (at 5V, IWR=IER=0mA)
- 5) The gain of preamplifier for differential voltage is 47.5 dB.
- 6) The IC incorporates a capacitor for setting constant and pulse width during data reading.
- 7) A differential constant switching circuit is built in.
- 8) Writing current is selectable in 4 stages (Stand density inner, standard density outer, high dencity inner, high dencity outer).
- 9) Time domain filter is selectable in 2 stages.
- MMM. DataSheetall.com 10) With a power supply undervoltage detection circuit builtin, illeagal writing is completely prohibted even upon buildup or undervoltage of the power supply.

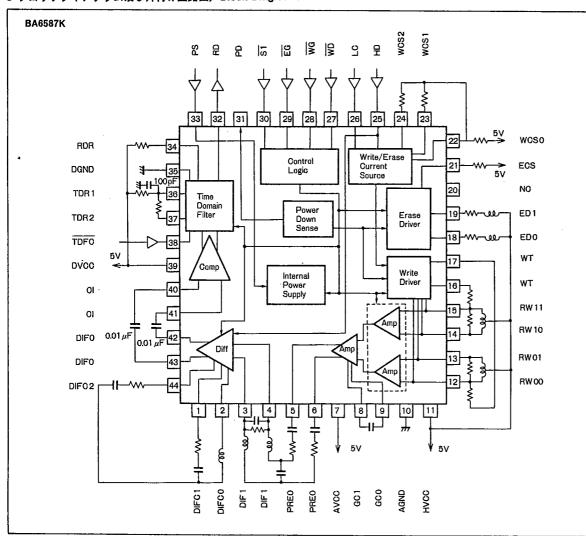
622

ROHM

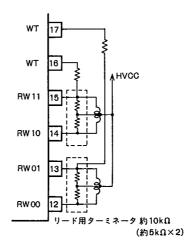
BA6587K/BA6588K

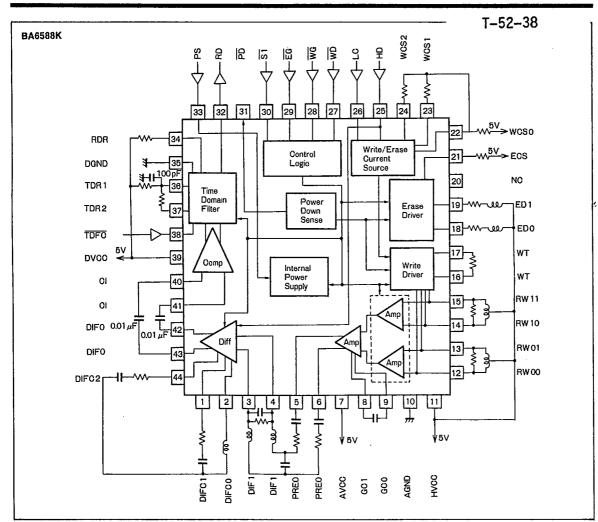
● ブロックダイアグラム及び外付け回路図/Block Diagram and External Circuit

T-52-38

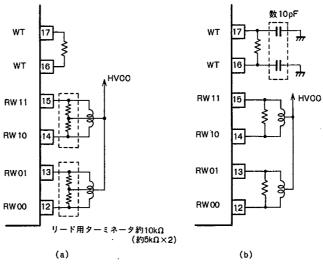


(注) リード・ライト・ヘッドの特性によって (特にコイルの位相が逆転する周波数 が 2MHz 付近にあるとき) ライト電流切り替わり時に電流波形が発振現象を 起こす場合があります。そのような場合は、右図のようなアプリケーション にて発振等が起こらないことを確認して使用してください。





(注) リード・ライト・ヘッドの特性によって(特にコイルの位相が反転する周波数が 2MHz 付近にあるとき)ライト電流切り替わり時に電流波形が発振現象を起こす場合があります。そのような場合は、右図の(a) または(b) のようなアプリケーションにて発振等が起こらないことを確認して使用してくださ



7828999 0004051 2 MRHM

OA 機器用 IC/ICs for OA Applications

BA6587K/BA6588K

T-52-38

● 端子機能説明

ブロック	端子番号	端子名	機能
	12	RW00	サイド0 R/W ヘッド接続端子
へッドスイッチ系	13	RW01	9 1 1 0 HZ W - V 1 3 3 3 4 0 1 3 1
ヘットスイック示	14	RW10	サイド1 R/W ヘッド接続端子
	15	RW11	7 1 1 1 1 1 7 44 1 7 1 35.49(5) 2 H 3
	9	GC0	 ゲイン調整端子
・ リードプリアンプ系	8	GC1	7 1 2 WILLIAM 1
) ())) ·) ·) ·)	6	PREO	プリアンプ差動出力端子
	5	PREO	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	4	DIFI	 微分器差動入力端子
	3	DIFI	DAY HA
	2	DIFC0	
微分器系	1	DIFC1	微分定数接続端子
	44	DIFC2	
	43	DIFO	微分器差動出力端子
	42	DIFO	JW77 HB722-07-70-70
コンパレータ系	41	CI	コンパレータ差動入力端子
	40	CI	
	37	TDR2	タイムドメインフィルタ時定数補正端子
タイムドメイン	36	TDR1	タイムドメインフィルタ設定端子
フィルタ系	34	RDR	リードデータ出力パルス幅設定端子
	32	RD	リードデータ出力
	22	WCS0	ライト電流設定端子
_	23	WCS1	ライト電流補正端子1(LC=Lのとき有効)
ライト系	24	WCS2	ライト電流補正端子2(HD=Hのとき有効)
	16	WT	ライトダンピング抵抗接続端子
	17	WT	
	18	ED0	サイドのイレーズ出力
イレーズ系	19	ED1	サイド1イレーズ出力
	21	ECS	イレーズ電流設定端子
	25	HD*1	標準密度/高密度切換端子
	26	LC*2	トラック内/外周切換端子
	27	WD	ライトデータ入力
コントロール	28	WG	ライト許可入力
ロジック入力	29	EG	イレーズ許可入力
	30	ST	
	33	PS TDFC*3	パワーセーブ入力 タイムドメインフィルタ定数切換入力
油品协山	38		
	31	PD	減電検出出力
	7	AVCC	アナログ系 VCC
電源系	39	DVCC	デジタル系 VCC
电源术	10	AGND	アナログ系 GND
	35	DGND	デジタル系 GND
	20	NC	ファルボ GND
	20	INC	

* 1, 2

HD	LC	ライト電流	微分器定数		
	L	22 ピンと 23 ピンと 24 ピンで設定された電流	44 ピンー2 ピン間の定数		
н	H H 22	22 ピンと 24 ピンで設定された電流	が有効		
	L	22 ピンと 23 ピンで設定された電流	1 ピンー2 ピン間の定数		
L	L H	22 ピンで設定された電流	が有効		

上記の補正端子は補正抵抗が設定抵抗に対して並列に働きます。 ★ 3 Lのとき補正あり

BA6587K/BA6588K

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
電源電圧	AVCC, DVCC	+7	V
电你电压	HV _{CC}	+16	٧
動作温度範囲	Topr	0~+70	•c
保存温度範囲	Tstg	−55∼125	°C
デジタル系入力電圧	V1	-0.3~DVCC+0.3	٧
RW 端子電圧	V _{RW}	+25	V
PD 出力電圧	V _{PD}	+16	٧
イレーズドライブ電流	IER	100	mA
EO 端子電圧	VER	+25	

T-52-38

● 推奨動作条件(Ta=0°C~70°C)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions
電源電圧範囲	HV _{CC}	4.4	5.0	6.0	. V	
電源電圧範囲	DVCC	4.4	5.0	6.0	٧	
電源電圧範囲	AVCC	4.4	5.0	6.0	٧	

● 電気的特性/Electrical Characteristics(Unless otherwise noted, Ta=25°C, HV_{CC}=AV_{CC}=DV_{CC}=5V)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Мах.	Unit	Conditions	Test Circuit
回路電流							
	Ісснѕ	_	0.01	0.03	mA	HV _{CC} 回路電流	
待機時回路電流	Iccos	_	0.85	1.3	mA	DV _{CC} 回路電流	Fig.3
	ICCAS	_	0.5	0.7	mA	AV _{CC} 回路電流	
リード時 回路電流	Icchr	_	1.7	2.4	mA	HV _{CC} 回路電流	
	ICCDR	_	21.5	29	mA	DV _{CC} 回路電流	Fig.3
	ICCAR	_	17	23.5	mA	AV _{CC} 回路電流	
ライト時 回路電流	Icchw	_	0.01*	0.05*	mA	HV _{CC} 回路電流	
(IWR=IER=OMA)	ICCDW	_	10	18	mA	DV _{CC} 回路電流	Fig.3
(IMH—IEH—OIIIA)	Iccaw	_	7.0	10	mA	AV _{CC} 回路電流	
咸 電検出回路							
スレッショルド電圧	V _{TH}	3.5	3.9	4.2	٧	AV _{CC} で減電を検出する	Fig.4
ヒステリシス電圧	VH	50	-	-	mV		Fig.4
出力 L レベル電圧	VoL	_	_	0.4	>	V _{CC} =2V I _{OL} =0.5mA	Fig.4
出力リーク電流	10н	_	_	1	μА		Fig.4

^{*} BA6588K の場合 Typ. 1.0mA, Max. 1.4mA

BA6587K/BA6588K

OA 機器用 IC/ICs for OA Applications

T-52-38

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions		(Test Circuit)
リカバリタイム								
POWER SAVE→READ	T _{r1}	+	-	1	ms	PSによる	*1	Fig.5
READ→WRITE	T _{r2}	-	-	4	μS	WGによる		Fig.5
	T _{r3W}	ı	_	300	μs	WG による	* 2	Fig.5
WRITE→READ	T _{r3E}	-	1	20	μs	EGによる		Fig.5
SIDE0++SIDE1	T _{r4}	_		40	με	S1 による		Fig.5
プリアンプ部								
差動電圧利得	G _{VD}	45.5	47.5	49.5	ВВ	f=250kHz, V _{IN} =	=2.5mVpp	Fig.6
周波数特性	BW	3	_	_	MHz	250kHz=0dB,	3dB 周波数	Fig.6
SIDE0++SIDE1クロストーク	GCTLK	50	_		dB	f=250kHz		Fig.6
差動入力抵抗	RID	20	_	_	kΩ			Fig.7
入力換算雑音電圧(1)	V _{N1}	_	4.5	8	μ V _{rms}	f=400~1MHz		Fig.8
入力換算雑音電圧(2)	V _{N2}	_	5	10	μ V _{rms}	f=400~1MHz *3		Fig.8
入力シンク電流	ISINK	_	100	200	μА			Fig.9
差動入力電圧最大振幅	V _{INmax}	_	_	15	mV _P -F		*	Fig.6
差動出力電圧振幅	Vop	2	-	T -	V PP	歪率 5%		Fig.6
差動出力抵抗	ROD	_	120	-	Ω			Fig.6
差動出力電流振幅	lop	5.8	7.4	_	mAp-p			Fig.6
	1				40	L=330 µ H		Fi- 10
同相信号除去比	CMRR	50	_	_	dB	V _{in} =100mV _{P-P}	, f=250kHz	Fig.10
AN 12 AN 22 → £1.00 ± 11.	2000	60	_		dB	L=330 μ H	f=125kHz	Fig 11
電源電圧変動除去比	PSRR	40	_	-	dB	Vin=100mVpP	f=400kHz	Fig.11
微分器								
電圧利得	G _{VD}	14	16	18	dB	f=250kHz, RE	=510Ω	Fig.12
周波数特性	BW	3	-	-	MHz	250kHz=0dB, -	-3dB周波数	Fig.12
DIFC1↔DIFC2クロストーク	GCTLK	45	-	-	dB	f=250kHz		Fig.12
差動入力抵抗	R _{ID}	30	_	-	kΩ			Fig.13
微分定数設定端子出力抵抗	R _{CD}	T -	100	_	Ω			Fig.12
微分定数設定端子電流	Isink	0.5	0.75	-	mA			Fig.14
差動出力抵抗	R _{OD}	_	50	_	Ω			Fig.12
差動出力電圧振幅	V _{OD}	2	-	-	V _P -P	歪率 5%		Fig.12
出力シンク電流	losink	1.8	2.8		mA			Fig.14

- 微分器ーコンパレータ間のカップリングコンデンサ 0.01 μF,微分器入力一GND 間のコンデンサ 1000pF 以下の場合
- *2 全項目において 44pin-2pin 間及び 1pin-2pin 間の微分定数内の C の値は 0.01 µF 以下とする。
- *3 微分器入力により 1V_P---p, 250kHz を入力し, TDF パルス幅 1.2 μs, RD パルス幅 0.5 μs に設定したとき。
- *4 8-9pin間を抵抗で補正したときを含む

T-52-38

BA6587K/BA6588K

ROHM CO LTD

40E D 7828999 0004054 8 RHM"

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions	Test Circuit
コンパレータ及び波形整形							
差動入力抵抗	R _{ID}	10	_	_	kΩ		Fig.15
最大差動入力電圧	V _{INmax}	4	_	-	V _P —P		Fig.16
TD M/M パルス幅設定範囲	tτD	500	-	3000	ns		Fig.16
TD M/M パルス幅精度 *5	E _{TD}	-20	_	+20	%	$R_{TD}=200k\Omega(t_{TD}=2.35 \mu s)$	m: 40
TD M/M バルス機構及 本で	E _{TD2}	-12	-	+12	%	$R_{TD}=40k\Omega$, $C_{TD}=100pF(*)$	Fig.16
TD M/M パルス幅電圧依	PStTD ₁	-12	-5	+4	%/V	R _{TD} =200kΩ(t _{TD} ≒2.35 μ s)	
存性 *5	PSt _{TD2}	-6	-1	+4	%/V	R _{TD} =40kΩ, C _{TD} =100pF(*)	Fig.16
RD M/Mパルス幅設定範囲	t _{RD}	125	_	1500	ns		Fig.16
RD M/Mパルス幅精度	E _{RD}	-20	-	+20	%	R _{RD} =36kΩ(t _{RD} =0.5 μ s)	Fig.16
RD M/Mパルス幅電圧依 存性	PS t _{RD}	-12	-2	+12	%/v	R _{RD} =36kΩ(<i>t</i> _{RD} ≒0.5 μ s)	Fig.16
立ち上がり時間	trun	ı	_	70	ns		Fig.16
立ち下がり時間	tтнь	_	_	25	ns		Fig.16
ピークシフト	P.S.	_	-	1	%	V _{IN} =0.15~2V _P P	Fig.16
ローレベル出力電圧	VoL	-	_	0.5	٧	I _{OL} =2mA	Fig.17
ハイレベル出力電圧	Voн	2.7	-	_	٧	I _{OH} =-0.4mA	Fig.17
ライト回路							
ライト電流設定範囲	1 _{WR}	2	-	20	mA	LC, HD 端子による補正電流を含む	Fig.18
補正ライト電流設定範囲	1 _{WC}	_	_	5	mA	LC, HD 端子各々において	Fig.18
ライト電流精度	ACIW	-7	-	+7	%	I _{WR} =6mA, R _{WCSO} =1.91kΩ	Fig.18
ライト電流ペア性	ΔiwR	-2	_	+2	%	R _{WCSO} =1.91kΩ	Fig.18
ライト電流電源電圧依存性	PSIW	-4	-2	+1	%/V	R _{WCSO} =1.91kΩ	Fig.18
出力飽和電圧	VSATRW	-	1.3	1.8	٧	*5	Fig.18
オフ時リーク電流	ILKRW1	-	-	20	μА	非選択側 V _{RW} =14V *5	Fig.18
オン時サーソ电流	I _{LKRW2}	-	_	50	μА	選択側 V _{RW} =14V <u>*6</u>	Fig.18
ライトデータ最小パルス幅	₩D	70	1	_	ns		Fig.19
タイミングバランス	ΔI _W	_	_	0.5	%	f=500kHz	Fig.18
イレーズ出力							
イレーズ電流設定範囲	IER	5	_	100	mA		Fig.20
出力飽和電圧	VSATER	_	0.8	1.4	٧	I _{ER} =100mA, R _{ECSO} =1.8kΩ	Fig.20
出力リーク電流	ЮН		_	100	μА	V _{OH} =20V	Fig.20

^{*5} TDR2 端子は OPEN

^{*6} lw=12mA に設定した出力電圧を下げていき lw が10.8mA になるときの RW 端子の電圧。

^{*7} HV_{CC}=12VのときはV_{RW}=20V

T-52-38

BA6587K/BA6588K

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Мах.	Unit	Conditions		Test Circuit
ロジック入力								
ハイレベル入力電圧 1	V _{IH} ,	2	-	-	٧	LC, HD, TDFC, PS		Fig.21
ローレベル入力電圧 1	V _{IL1}	_	_	0.8	٧	LC, HD, TDFC, PS		Fig.21
ハイレベル入力電圧 2	V _{IH2}	2		_	٧	WG, EG, S1		Fig.21
ローレベル入力電圧 2	V _{IL2}	_	_	0.8	٧	WG, EG, S1		Fig.21
入力電圧 2 ヒステリシス	V _{H2}	0.2	_	-	٧	WG, EG, S1		Fig.21
ハイレベル入力電圧 3	V _{IH3}	2	_	_	٧	WD		Fig.21
ローレベル入力電圧 3	V _{IL3}	_	_	0.7	٧	WD		Fig.21
入力電圧3ヒステリシス	V _{H3}	0.2	-	-	٧	WD		Fig.21
ハイレベル入力電流 1	I _{IH1}	_	_	10	μΑ	LC, HD, TDFC, PS	V _{OH} =2.8V	Fig.21
ローレベル入力電流 1	I _{IL}	_	-	40	μА	LC, HD, TDFC, PS	V _{OL} =0.4V	Fig.21
ハイレベル入力電流 2	I _{IH2}	_	-	10	μА	WG, EG, S1	V _{OH} =2.8V	Fig.21
ローレベル入力電流 2L	I _{IL2}	_	-	40	μА	WG, EG, S1	V _{OL} =0.4V	Fig.21
ハイレベル入力電流 3	l _{IH3}	_	_	10	μА	WD	V _{OH} =2.8V	Fig.21
ローレベル入力電流3	l _{IL3}	_	_	400	μА	WD	V _{OL} =0.4V	Fig.21

(注 9) タイムドメインフィルタ TD M/M パルス幅設定用端子 TDR1 は 内部に 15pF 内蔵しており、AVCC にブルアップした外付け抵 抗 R_{TD}のみによって TD M/M パルス幅を決定することができます。しかしそのように使用した場合,TDFC=H(補正を行わな い)ときに TDR2 端子の内部容量の影響で TD M/M パルス幅が,周波数特性を持ってしまうので,使用の際は十分注意してくだ さい。

また、TDR1 端子-GND 間に外付けで CTD=100pF 挿入して時定数を調整し使用することによって、TDR2 端子の内部容量の影 響が小さくなり、周波数に対して安定した特性が得られるようになります。また TDR1 内蔵の 15pF の内部容量のバラツキの影 響も小さくなり TD M/M パルス幅タイミング精度も向上します。

なお C_{TD}=100pF と C_{TD}=OPEN のときのコンパレータ入力周波数対 TD M/M パルス幅のグラフを Fig.2 に示します。

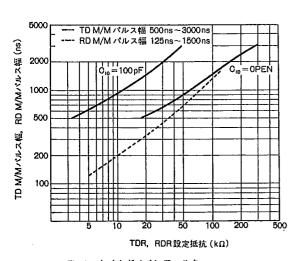


Fig.1 タイムドメインフィルタ

(注8) TDR1-TDR2間の補正抵抗をつけずにTDFC=Hにしたときの値

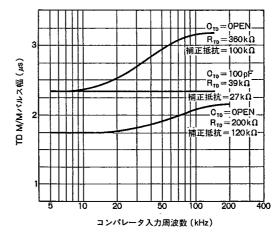


Fig.2 コンパレータ入力周波数対 TDMM パルス幅 (TDFC=H:補正は行わない)

BA6587K/BA6588K

T-52-38

● 測定回路図/Test Circuits

(1) 消費電流

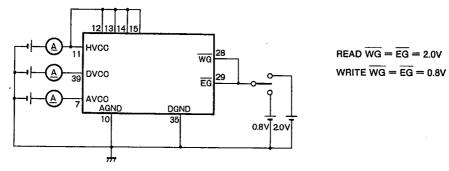
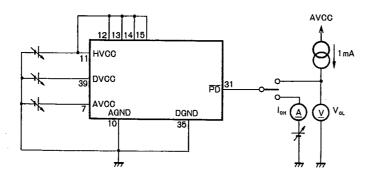


Fig.3 消費電流 ICCHS, ICCHR, ICCHW, ICCDS, ICCDR, ICCDW, ICCAS, ICCAR, ICCAW 測定回路

(2) 減電圧検出(AVCCにより検出)



モニタ I_{WR} (RW 00, RW 01, RW 10, RW 11) I_{ER} (E₀0, E₀1)

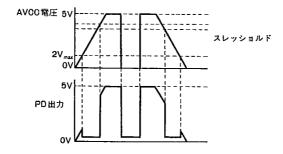
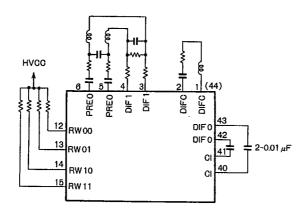


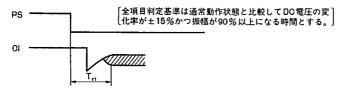
Fig.4 V_{TH}, Ý_H, V_{OL}, I_{OH} 測定回路

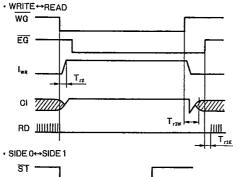
(3) リカバリタイム

T-52-38



· POWER SAVE→READ





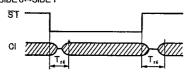


Fig.5 T_{r1}, T_{r2}, T_{r3W}, T_{r3E}, T_{r4} 測定回路

(4) プリアンプ

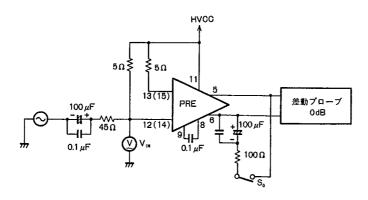
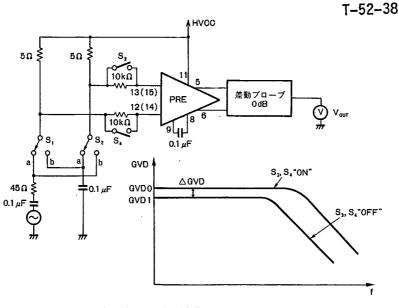


Fig.6 G_{VD}, BW, G_{CTLK}, V_{INmax}, V_{OD}, R_{OD} 測定回路



$$R_{10} = \left(\frac{10^{-44 \text{VOM/23}}}{1 - 10^{-44 \text{VOM/23}}} + \frac{10^{-44 \text{VOM/23}}}{1 - 10^{-44 \text{VOM/23}}}\right) \times 10 \text{ [k\Omega]}$$

Fig.7 差動入力抵抗 R_{ID} 測定回路

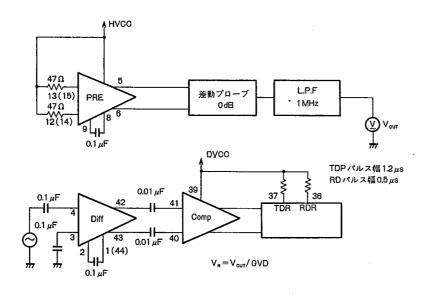


Fig.8 入力換算雑音電圧 V_{N1}, V_{N2} 測定回路

注 V_{N1}測定には微分器に信号を入力しない。 V_{N2}測定時には微分器に入力し、リード・データを出力させる。

T-52-38

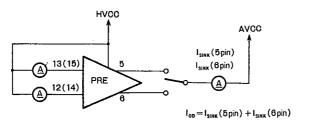


Fig.9 入力シンク電流 I_{SINK}, 差動出力電流振幅 I_{OD} 測定回路

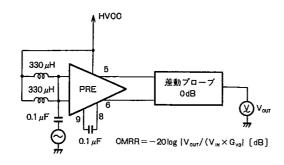


Fig.10 同相信号抑圧比 CMRR 測定回路

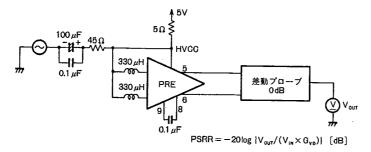


Fig.11 電圧変動抑圧比 PSRR 測定回路

(5) 微分器

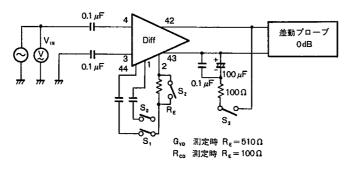
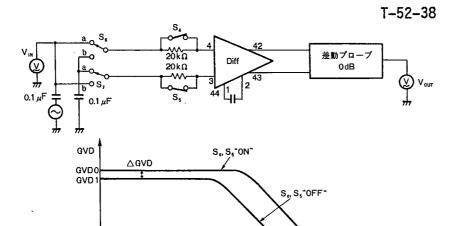


Fig.12 GVD, BW, GCTLK, RCD, VOD, ROD 測定回路

F



$$R_{1D} = \left(\frac{10^{-\Delta \text{GVDa}/20}}{1 - 10^{-\Delta \text{GVDa}/20}} + \frac{10^{-\Delta \text{GVDb}/20}}{1 - 10^{-\Delta \text{GVDb}/20}}\right) \times 20 (k\Omega)$$
 $\Delta \text{GVDaはS6} \cdot \text{S7} \cdot \text{aの時の}\Delta \text{GVD}(\text{dB})$
 $\Delta \text{GVDaはS6} \cdot \text{Sb} \cdot \text{aの時の}\Delta \text{GVD}(\text{dB})$

Fig.13 差動入力抵抗 R_{ID} 測定回路

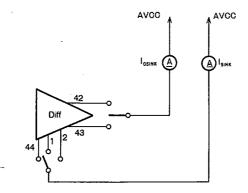


Fig.14 微分定数設定端子電流, 出力シンク電流測定回路

BA6587K/BA6588K

(6) コンパレータ及び波形整形

T-52-38

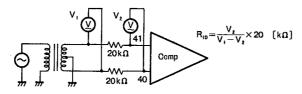


Fig.15 コンパレータ差動入力抵抗 R_{ID} 測定回路

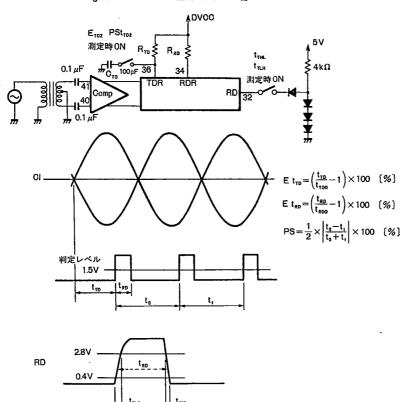


Fig.16 V_{INmax}, t_{TD}, E_{TD}, t_{RD}, E_{RD}, P.S. 測定回路

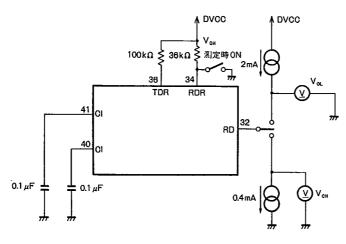
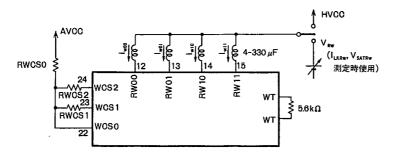


Fig.17 VOH, VOL 測定回路

(7) ライト回路

T-52-38



ライト電流定義

$$I_{WRO} = \frac{1.22V}{RWCSO} \times 9.6$$

補正ライト電流設定式

I_{WC20}=

$$I_{WC1O} = \frac{1.22V - V_{WCS}}{RWCS_1} \times 9.6$$
 $V_{WCS1}:AVCC - WCS1$ 間の電圧(LC によって制御) $I_{WC2O} = \frac{1.22V - V_{WCS_2}}{RWCS_2} \times 9.6$ $V_{WCS_2}:AVCC - WCS2$ 間の電圧(HD によって制御)

$$ACI_{W} = \frac{I_{WR} - 6(mA)}{6(mA)} \times 100 \qquad R_{WCS0} = 1.91k\Omega$$

$$\Delta I_{WR} = \frac{2 \mid I_{W_{00}} - I_{W_{01}} \mid}{\mid I_{W_{00}} + I_{W_{01}} \mid} \times 100$$
$$= \frac{2 \mid I_{W_{10}} - I_{W_{11}} \mid}{\mid I_{W_{10}} + I_{W_{11}} \mid} \times 100$$

RWCS2

$$PSIW = \frac{2 | I_{WH} - I_{WL}|}{| I_{WH} + I_{WL}|} \times \frac{1}{1.6}$$

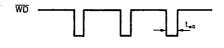
IWH: AVCC=6.0V 時のライト電流

I_{WL}: AVCC=4.4V 時のライト電流

選択側オフセット電流 定義:

選択側 RW 両端子に ライト電流以外に均等に流れる電流(ライトターミネータ回路起動用)

Fig.18 BA6588Kの IWR, ACIW, ΔIWR, VSATRW, ILKRW, IWC, LRWOFF 測定回路



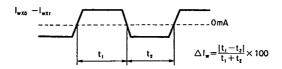


Fig.19 ΔI_W, t_{WD} 定義波形

BA6587K/BA6588K

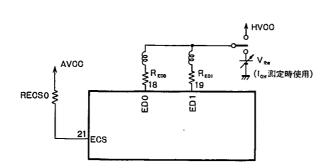
ROHM CO LTD

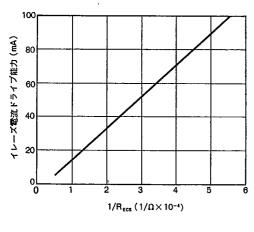
(8) イレーズ回路

40E D

7828999 0004063 9 🔤 RHM

T-52-38





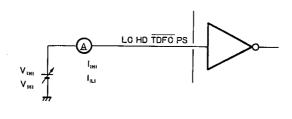
イレーズ電流 I_{ER}(5mA~100mA) イレーズ出力が設定電流値以上のドライブ能力となるよ うに上記のグラフより AVCC-ECS 間の抵抗(R_{ECS})を 決定する。

イレーズ電流は次の式により決定する。 $t_{ER} = \frac{V_{CC} - (V_{SATER} + V_{EHEAD})}{R_{ED}}$ VEHEAD: イレーズ・ヘッドによる電圧降下

RED : EOo 選択時 REDO EO, 選択時 RED1

Fig.20 IER, IOH, VSATER 測定回路

(9) コントロールロジック



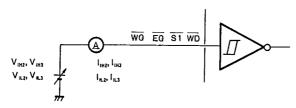


Fig.21 V_{IH}, V_{IL}, I_{IH}, I_{IL}, V_H 測定回路